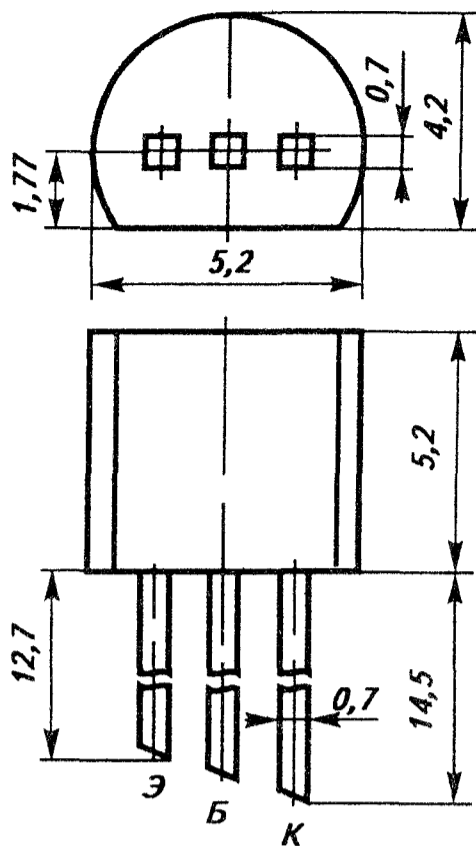


□ КТ645А, КТ645Б

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *n p n* универсальные. Предназначены для применения в высокочастотных генераторах и усилителях в быстродействующих импульсных устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Масса транзистора не более 0,3 г.



КТ645(А,Б)

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ	
КТ645А при $U_{кб} = 2$ В $I_{э} = 150$ мА	20 200
КТ645Б при $U_{кб} = 10$ В $I_{э} = 2$ мА, не менее	80
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 10$ В	
$I_{э} = 50$ мА	
не менее	200 МГц
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте при $U_{кб} = 5$ В	
$I_{э} = 5$ мА $f = 5$ МГц	
не более	120 пс
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, не более	
КТ645А при $I_{к} = 150$ мА, $I_{б} = 15$ мА	0,5 В
КТ645Б при $I_{к} = 10$ мА $I_{б} = 1$ мА	0,05 В
Время рассасывания при $I_{к} = 150$ мА, $I_{б} = 15$ мА, не более	50 нс
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 10$ В, не более	5 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{эб} = 0$, не более	50 пФ
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = U_{кб, макс}$ не более	
$T = -45 \dots +25^{\circ}\text{C}$	10 мкА
$T = +85^{\circ}\text{C}$	100 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 4$ В, не более	10 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база	
КТ645А	60 В
КТ645Б	40 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{бэ} = 1$ кОм	
КТ645А	50 В
КТ645Б	40 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	4 В
Постоянный ток коллектора	300 мА
Импульсный ток коллектора при $t_{и} = 10$ мкс $Q = 5$	600 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора ¹	
при $T = -45 \dots +25^{\circ}\text{C}$	0,5 Вт
при $T = +85^{\circ}\text{C}$	0,25 Вт
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при $t_{и} = 10$ мкс, $Q = 5$,	
$T = -45 \dots +55^{\circ}\text{C}$	1 Вт
Температура <i>p-n</i> перехода	+150°C
Температура окружающей среды	45 \dots +85°C

¹ При T от +25 до +85°C максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора уменьшается линейно.

Изгиб выводов транзистора не ближе 5 мм от корпуса с радиусом закругления 1,5 мм. Пайка выводов транзистора допускается не ближе 3 мм от корпуса при температуре не выше +270°C в течение не более 10 с.

Допустимое значение статического потенциала 1000 В.